

129НТ1-1, 159НТ1, Б1129НТ1-1, 1129НТ1

Дифференциальная пара транзисторов

Общее описание

Дифференциальная пара включает в себя два согласованных по характеристикам пропорциональных транзистора. Транзисторы максимально отделены друг от друга диэлектрической изоляцией и в схеме применения не требуют специального смещения для разделения.

Расположение транзисторов на одном кристалле обеспечивает максимальную идентичность характеристик транзисторов, в том числе и на высоких частотах.

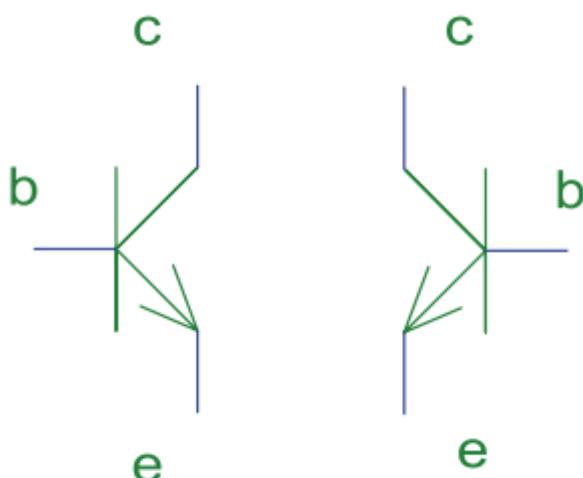
Бескорпусные дифференциальные пары транзисторов 129НТ1-1, Б1129НТ1-1 и их корпусные аналоги 159НТ1, 1129НТ1 могут применяться везде, где требуется хорошее согласование характеристик двух транзисторов.

Наиболее типичное применение такие пары транзисторов находят во входных цепях операционных усилителей. Дифференциальные пары серии 1129 отличаются повышенной радиационной стойкостью.

Важнейшие характеристики

- Малый ток утечки между транзисторами (10 нА)
- Большой выбор статических коэффициентов передачи тока
- Малые отличия статических коэффициентов передачи тока (отношение не менее 0.9)
- Малая разность напряжений эмиттер-база (не более 3 мВ)

Схема электрическая



Состав серий

Наименование	Коэф. усиления тока	Отношение коэф. усиления тока	Разность напряжений эмиттер-база/ мВ	Корпус	Диапазон рабочих температур, °C
129HT1A-1	(30;90)	0.9	3	-	(-60;125)
129HT1Б-1	(60;180)				
129HT1В-1	>80				
129HT1Г-1	(30;90)				
129HT1Д-1	(60;180)				
129HT1Е-1	>80				
129HT1Ж-1	(40;160)				
K129HT1A-1	(20;80)				
K129HT1Б-1	(60;180)				
K129HT1В-1	>80				
K129HT1Г-1	(20;80)	0.85	15	301.8-2, 3101.8-НБ, TB13-6	(-60;85)
K129HT1Д-1	(60;180)				
K129HT1Е-1	>80				
K129HT1Ж-1	(40;160)				
159HT1A	(30;90)				
159HT1Б	(60;180)	0.9	3	-	(-60;125)
159HT1В	>80	0.92			
159HT1Г	(30;90)	0.8			
159HT1Д	(60;180)	10	-	(-60;85)	
159HT1Е	>80				
K159HT1A	(20;80)	0.85	3	-	(-60;125)
K159HT1Б	(60;180)				
K159HT1В	>80				
K159HT1Г	(20;80)	0.75	15	-	(-60;85)
K159HT1Д	(60;180)				
K159HT1Е	>80				
1129HTB1	(80;360)	0.9	3	-	(-60;125)
Б1129HT1В-1	(80;600)				

Назначение выводов

Вывод	Назначение	
	129HT1-1, K1129HT1-1, Б1129HT1-1	159HT1, K159HT1, 1129HT1
1	Коллектор 2	Не используется
2	База 2	Коллектор 1
3	Эмиттер 2	База1
4	Коллектор 1	Эмиттер 1
5	База 1	Не используется
6	Эмиттер 1	Эмиттер 2
7	-	База 2
8	-	Коллектор 2

Предельные режимы и условия

Параметр или условие	Max	Примечание
Напряжение коллектор-база/ В	20	129HT1, 159HT1, K159HT1
	15	K129HT1, 1129HT1
	12	B1129HT1
Напряжение коллектор-эмиттер/ В	20	159HT1, K159HT1
	15	129HT1
	13	1129HT1
	10	B1129HT1
Напряжение эмиттер-база	4	
Напряжение между транзисторами/ В	25	129HT1, 159HT1, B1129HT1, 1129HT1
	20	K129HT1, K159HT1
Ток коллектора/ мА	10	
Ток коллектора импульсный/ мА	40	
Температура перехода/ °C	150	
Мощность рассеивания/ мВт	75	159HT1, 1129HT1
	50	K159HT1
	15	129HT1, K129HT1, B1129HT1

Электрические параметры

Параметр	Темпе- ратура	Min	Max	Примечание
Обратный ток коллектора/ нА				
129HT1	25°C		20	При напряжении 20 В
	Раб.		5000	
K129HT1	25°C		200	При напряжении 15 В
	Раб.		2000	
159HT1	25°C		20	При напряжении 20 В
	Раб.		1000	
K159HT1	25°C		200	
	Раб.		5000	
B1129HT1-1	25°C		20	При напряжении 12 В
	Раб.		500	
1129HT1	25°C		10	При напряжении 15 В
	Раб.		1000	
Обратный ток эмиттера/ нА				
129HT1, 159HT1	25°C		50	При напряжении 4 В
	Раб.		1000	
K129HT1, K159HT1	25°C		500	
	Раб.		5000	
B1129HT1-1	25°C		50	
	Раб.		500	
1129HT1	25°C		30	
	Раб.		10000	

Обратный ток коллектора-эмиттера/нА				
129HT1	25°C	50	При напряжении 15 В	
	Раб.	5000		
159HT1	25°C	50	При напряжении 20 В	
	Раб.	5000		
B1129HT1-1	25°C	50	При напряжении 10 В	
	Раб.	2500		
1129HT1	25°C	30	При напряжении 13 В	
	Раб.	5000		
Ток утечки между транзисторами/ нА				
129HT1, 159HT1, B1129HT1-1, 1129HT1	25°C	10	При напряжении 25 В	
	Раб.	300		
K129HT1, K159HT1	25°C	20	При напряжении 20 В	
	Раб.	200		
Коэффициент усиления тока				На частоте 50 Гц
129HT1A,Г, 159HT1A,Г	25°C	30	90	На токе 1 мА
	Раб.	13	180	
129HT1Б,Д, 159HT1Б,Д	25°C	60	180	На токе 1 мА
	Раб.	25	360	
129HT1B,E, K129HT1B,E, 159HT1B,E	25°C	80	-	На токе 50 мкА
	Раб.	32	-	
129HT1Ж, K129HT1Ж	25°C	40	160	На токе 1 мА
	Раб.	16	320	
K129HT1A,Г	25°C	20	80	На токе 1 мА
	Раб.	10	160	
K129HT1Б,Д	25°C	60	180	На токе 1 мА
	Раб.	24	360	
K159HT1A	25°C	20	80	На токе 1 мА
	Раб.	10	200	
K159HT1Б	25°C	60	180	На токе 1 мА
	Раб.	24	450	
K159HT1B,E	25°C	80	-	На токе 50 мкА
	Раб.	30	-	
B1129HT1-1	25°C	80	600	На токе 1 мА
	Раб.	32	-	
1129HT1	25°C	80	360	На токе 1 мА
	Раб.	35	720	

Отношение коэффициентов усиления тока				
129HT1A,Б,Ж, 159HT1A,Б, B1129HT1-1, 1129HT1	25°C	0.9	На токе 1 мА	
	Раб.	0.8		
129HT1B, 159HT1B	25°C	0.92	На токе 50 мкА	
	Раб.	0.8		
129HT1Г,Д, 159HT1Г,Д	25°C	0.8	На токе 1 мА	
	Раб.	0.7		
129HT1E, 159HT1E	25°C	0.8	На токе 50 мкА	
	Раб.	0.7		
K129HT1A,Б,Ж, K159HT1A,Б	25°C	0.85	На токе 1 мА	
K129HT1B, K159HT1B			На токе 50 мкА	
K129HT1Г,Д, K159HT1Г,Д	25°C	0.75	На токе 1 мА	
K129HT1E, K159HT1E			На токе 50 мкА	

Модуль коэффициента передачи тока				На частоте 100 МГц
129НТ1А,Г,Д,Е,Ж, К129НТ1А-Ж, 159НТ1А-Е, 1129НТ1	25°C	2.5		
129НТ1Б		3.5		
129НТ1В, Б1129НТ1-1		4.5		
К159НТ1А-Е		2		
Напряжение эмиттер-база/ В				
129НТ1, 159НТ1	25°C	0.55	0.75	При токе 1 мА
Разность напряжений эмиттер-база/ мВ				
129НТ1А-В,Ж, 159НТ1А-В,	25°C		3	
	Раб.		5	
129НТ1А-В,Ж, 159НТ1Г-Е,	25°C		10	
	Раб.		16	
129НТ1А-В,Ж, 159НТ1А-В, Б1129НТ1-1, 1129НТ1	25°C		3	
	Раб.		5	
129НТ1Г-Е, 159НТ1Г-Е,	25°C		10	
	Раб.		16	
К129НТ1А-В,Ж, К159НТ1А-В	25°C		3	
К129НТ1Г-Е, К159НТ1Г-Е	25°C		15	
Емкость коллекторного перехода, пФ				
129НТ1А-Ж, 159НТ1А-Е, 1129НТ1	25°C		3	
Емкость эмиттерного перехода, пФ				
129НТ1А-Ж, 159НТ1А-Е			4	